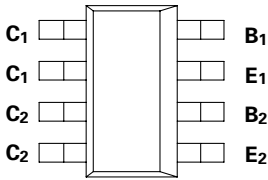


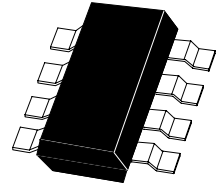
SM-8 DUAL NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTORS

ISSUE 1 - NOVEMBER 1995

ZDT694



PARTMARKING DETAIL - T694



SM-8
(8 LEAD SOT223)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CB0}	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	120	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}^*$ Any single die "on" Both die "on" equally	P_{tot}	2.25 2.75	W W
Derate above 25°C^* Any single die "on" Both die "on" equally		18 22	mW/°C mW/°C
Thermal Resistance - Junction to Ambient* Any single die "on" Both die "on" equally		55.6 45.5	°C/W °C/W

* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.

ZDT694

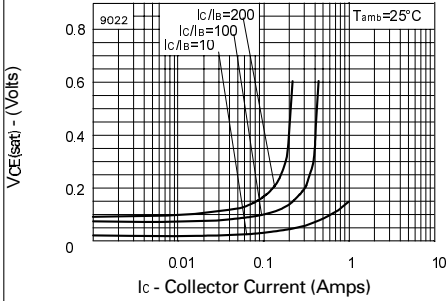
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	120			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=100\text{V}$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.25 0.5	V V	$I_C=0.1\text{A}, I_B=0.5\text{mA}^*$ $I_C=0.4\text{A}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	$I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			0.9	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500 400 150				$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=200\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=400\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	130			MHz	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		200		pF	$V_{EB}=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		9		pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		80 2900		ns ns	$I_C=100\text{mA}, I_{B1}=10\text{mA}$ $I_{B2}=10\text{mA}, V_{CC}=50\text{V}$

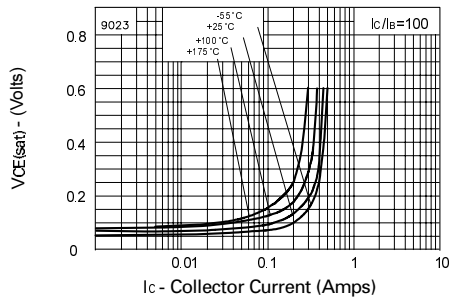
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

ZDT694

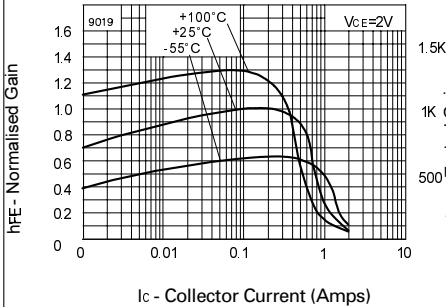
TYPICAL CHARACTERISTICS



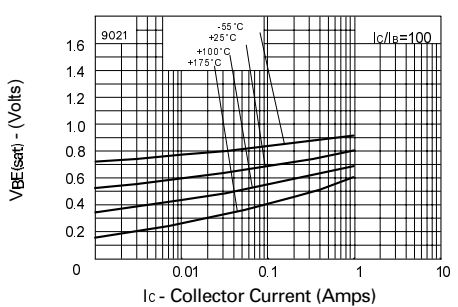
$V_{CE(sat)}$ v I_C



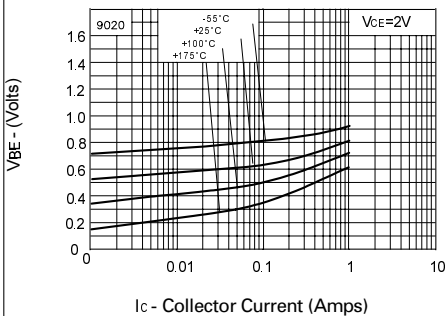
$V_{CE(sat)}$ v I_C



h_{FE} v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331